

**1. 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)**
**1.1 极限值(绝对最大额定值) ( $T_a=25^{\circ}\text{C}$ )**

参数	符号	规格	单位
集电极-基极电压	$V_{CB0}$	-50	V
集电极电流	$I_C$	-3	A
集电极功耗	$P_C$	1.25	W
结温	$T_j$	150	$^{\circ}\text{C}$

**1.2 电特性 ( $T_a=25^{\circ}\text{C}$ )**

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
集电极-基极击穿电压	$BV_{CB0}$	$I_C=-0.1\text{mA}, I_E=0$	-50			V
集电极-发射极击穿电压	$BV_{CEO}$	$I_C=-1\text{mA}, I_B=0$	-30			V
发射极-基极击穿电压	$BV_{EBO}$	$I_E=-0.1\text{mA}, I_C=0$	-7			V
集电极-基极截止电流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=-30\text{V}, I_E=0$			-0.5	$\mu\text{A}$
发射极-基极截止电流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=-3\text{V}, I_C=0$			-0.5	$\mu\text{A}$
直流电流增益	$h_{FE}$	$V_{CE}=-2\text{V}, I_C=-1\text{A}$	100		400	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-2\text{A}, I_B=-200\text{mA}$			-0.5	V
基极-发射极饱和电压	$V_{BE(sat)}$	$I_C=-2\text{A}, I_B=-200\text{mA}$			-2	V
特征频率	$f_T$	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-0.1\text{A}, f=10\text{MHz}$	50	80		MHz

注意事项: